



Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	R_{thCH}		0,65		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions		$T_{\text{vj op}}$	-40		150	°C

Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$	V_{RRM}		650		V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		I_{F}		25		A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	$t_{\text{p}} = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}		50		A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_{\text{R}} = 0 \text{ V}$, $t_{\text{p}} = 10 \text{ ms}$, $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$	I^2t		50,0		A ² s

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	$I_{\text{F}} = 25 \text{ A}$, $V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$ $I_{\text{F}} = 25 \text{ A}$, $V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$ $I_{\text{F}} = 25 \text{ A}$, $V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	V_{F}	1,65 1,60 1,55	2,15	V V V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	$I_{\text{F}} = 25 \text{ A}$, $-di_{\text{F}}/dt = 3000 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{\text{vj}}=150^\circ\text{C}$) $V_{\text{R}} = 300 \text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -15 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	I_{RM}	45,0 48,0 51,0		A A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	$I_{\text{F}} = 25 \text{ A}$, $-di_{\text{F}}/dt = 3000 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{\text{vj}}=150^\circ\text{C}$) $V_{\text{R}} = 300 \text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -15 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	Q_{r}	1,05 1,65 1,90		μC μC μC
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	$I_{\text{F}} = 25 \text{ A}$, $-di_{\text{F}}/dt = 3000 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{\text{vj}}=150^\circ\text{C}$) $V_{\text{R}} = 300 \text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -15 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	E_{rec}	0,25 0,39 0,44		mJ mJ mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode		R_{thJC}	1,25	1,45	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		R_{thCH}	0,95		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{\text{vj op}}$	-40	150	°C

NTC-Widerstand / NTC-Thermistor

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand Rated resistance	$T_{\text{C}} = 25^\circ\text{C}$		R_{25}	5,00		k Ω
Abweichung von R100 Deviation of R100	$T_{\text{C}} = 100^\circ\text{C}$, $R_{100} = 493 \Omega$		$\Delta R/R$	-5	5	%
Verlustleistung Power dissipation	$T_{\text{C}} = 25^\circ\text{C}$		P_{25}		20,0	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		$B_{25/50}$	3375		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		$B_{25/80}$	3411		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		$B_{25/100}$	3433		K

Angaben gemäß gültiger Application Note.
Specification according to the valid application note.

prepared by: AS	date of publication: 2014-03-05
approved by: TR	revision: 3.0



Modul / Module

Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V _{ISOL}	2,5		kV
Innere Isolation Internal isolation	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)		impr. Al ₂ O ₃		
Kriechstrecke Creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		11,5 6,3		mm
Luftstrecke Clearance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		10,0 5,0		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index		CTI	> 200		
			min.	typ.	max.
Modulstreuintuktivität Stray inductance module		L _{sCE}		15	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip Module lead resistance, terminals - chip	T _c = 25°C, pro Schalter / per switch	R _{CC+EE'}		5,50	mΩ
Lagertemperatur Storage temperature		T _{stg}	-40		125 °C
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder mounting force per clamp		F	20	-	50 N
Gewicht Weight		G		24	g

Der Strom im Dauerbetrieb ist auf 25 A effektiv pro Anschlusspin begrenzt.
The current under continuous operation is limited to 25 A rms per connector pin.
VGE muss im Kurzschluss auf 15V begrenzt werden (z.B. Klemmschaltung).
VGE has to be limited to 15V during shortcircuit (e.g. clamping).

prepared by: AS	date of publication: 2014-03-05
approved by: TR	revision: 3.0